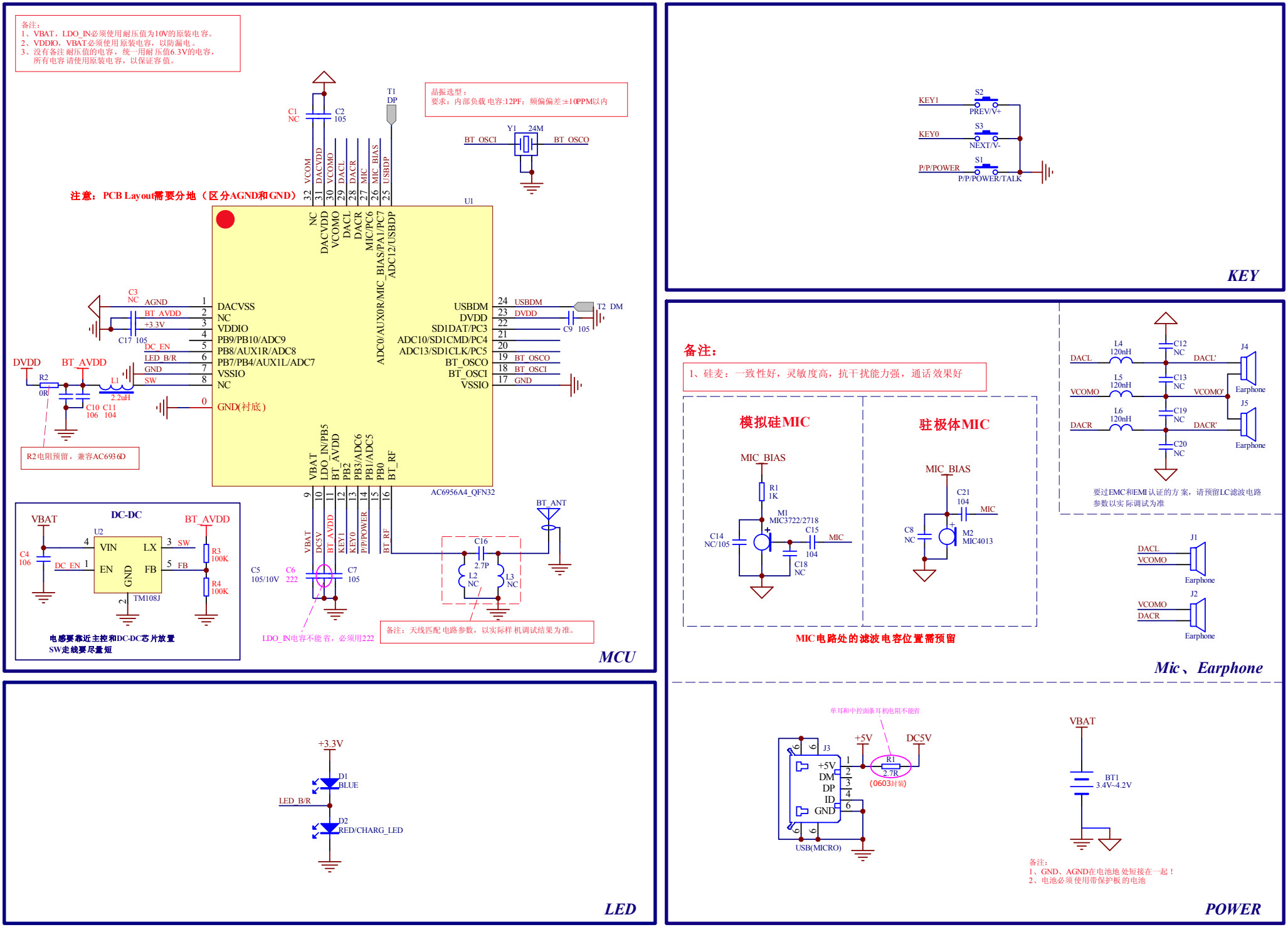

备注：
1、VBAT，LDO_IN必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
3、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
所有电容请使用原装电容，以保证容值。
晶振选型：
要求：内部负载电容:12PF；频偏偏差±10PPM以内
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
U1
AC6956A4_QFN32
DACVSS
NC
VDDIO
PB9/PB10/ADC9
PB8/AUX1R/ADC8
PB7/PB4/AUX1L/ADC7
VSSIO
NC
GND(衬底)
USBDM
DVDD
SD1DAT/PC3
ADC10/SD1CMD/PC4
ADC13/SD1CLK/PC5
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
ADC0/AUX0R/MIC_BIAS/PA1/PC7
ADC12/USBDP
R2电阻预留，兼容AC6936D
DC-DC
电感要靠近主控和DC-DC芯片放置
SW走线要尽量短
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
MCU
KEY1
KEY0
P/P/POWER
PREV/V+
NEXT/V-
P/P/POWER/TALK
KEY
备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
驻极体MIC
MIC_BIAS
MIC电路处的滤波电容位置需预留
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路
参数以实际调试为准
Earphone
Mic、Earphone
+3.3V
LED_B/R
D1
BLUE
D2
RED/CHARG_LED
LED
单耳和中控面条耳机电阻不能省
USB(MICRO)
(0603封装)
VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地处短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池
POWER